

BR3500W - BR3510W SILICON BRIDGE RECTIFIERS

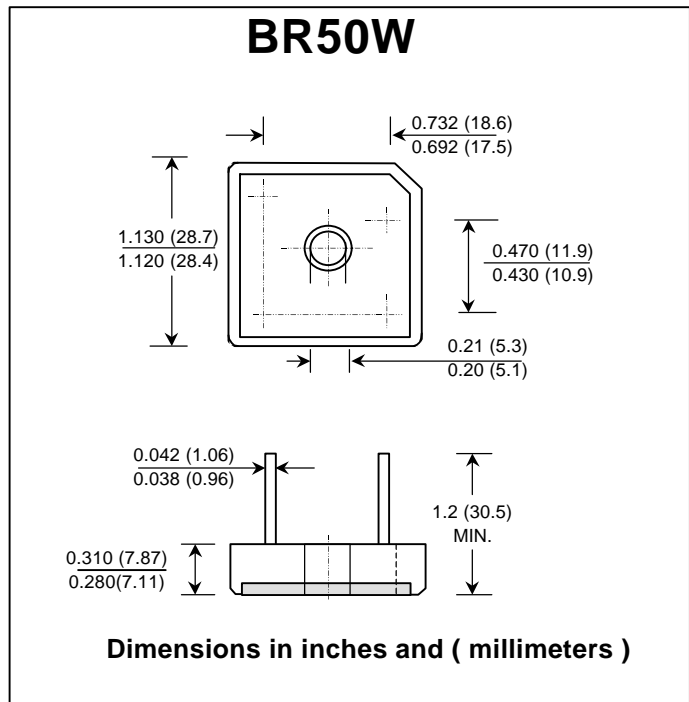
PRV : 50 - 1000 Volts
Io : 35 Amperes

FEATURES :

- * High current capability
- * High surge current capability
- * High reliability
- * Low reverse current
- * Low forward voltage drop
- * High case dielectric strength
- * Pb / RoHS Free

MECHANICAL DATA :

- * Case : Molded plastic with heatsink integrally mounted in the bridge encapsulation
- * Epoxy : UL94V-O rate flame retardant
- * Terminals : Plated lead solderable per MIL-STD-202, Method 208 guaranteed
- * Polarity : Polarity symbols marked on case
- * Mounting position : Bolt down on heat-sink with silicone thermal compound between bridge and mounting surface for maximum heat transfer efficiency
- * Weight : 15.95 grams



MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Rating at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.
 Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.
 For capacitive load, derate current by 20%.

RATING	SYMBOL	BR 3500W	BR 3501W	BR 3502W	BR 3504W	BR 3506W	BR 3508W	BR 3510W	UNITS
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V _{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum RMS Voltage	V _{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	V
Maximum DC Blocking Voltage	V _{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum Average Forward Current T _c = 55°C	I _{F(AV)}	35							A
Peak Forward Surge Current Single half sine wave Superimposed on rated load (JEDEC Method)	I _{FSM}	400							A
Current Squared Time at t < 8.3 ms.	I ² t	660							A ² S
Maximum Forward Voltage per Diode at I _F = 17.5 A	V _F	1.1							V
Maximum DC Reverse Current Ta = 25 °C at Rated DC Blocking Voltage Ta = 100 °C	I _R	10							μA
	I _{R(H)}	200							mA
Typical Thermal Resistance at Junction to Case (Note 1)	R _{θJC}	1.5							°C/W
Typical Thermal Resistance at Junction to Ambient	R _{θJA}	10							°C/W
Operating Junction Temperature Range	T _J	- 40 to + 150							°C
Storage Temperature Range	T _{STG}	- 40 to + 150							°C

Notes :

1. Thermal Resistance from junction to case with units mounted on a 7.5" x 3.5" x 4.6" (19cm.x 9cm.x 11.8cm.) Al.-Finned Plate

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (BR3500W THRU BR3510W)

FIG.1 - DERATING CURVE FOR OUTPUT RECTIFIED CURRENT

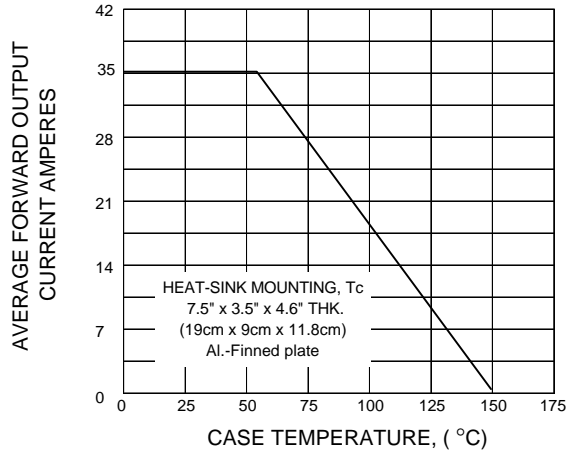


FIG.2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD SURGE CURRENT

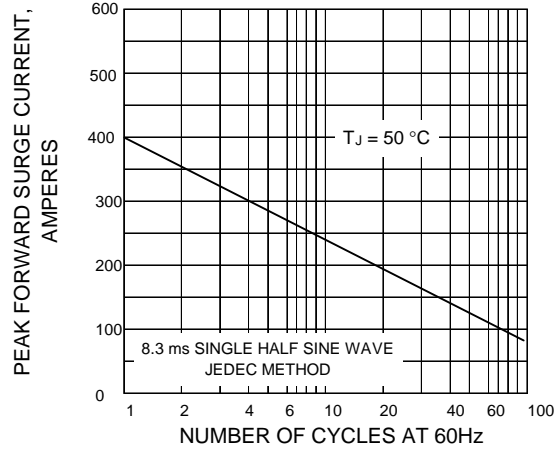


FIG.3 - TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS PER DIODE

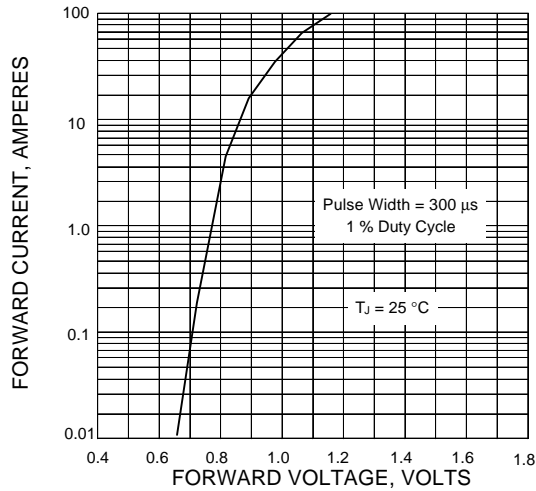
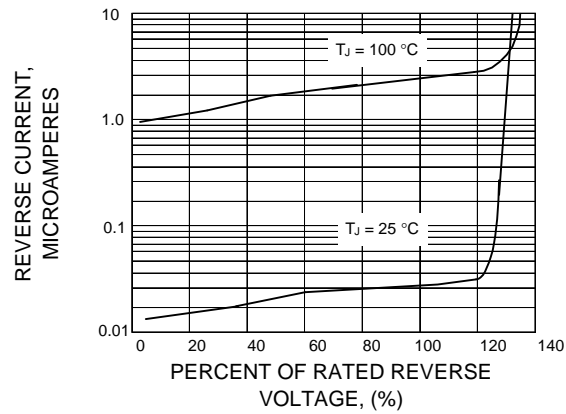


FIG.4 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS PER DIODE



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9